
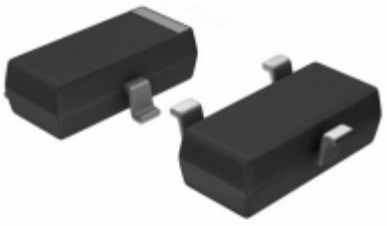
	<h2>SI2304DDS-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2304DDS-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 3.3A SOT23</p> <p>Datenblätter:  SI2304DDS-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 149407 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2304DDS-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 3.3A SOT23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	149407 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 3.3A (Ta), 3.6A (Tc) 1.1W (Ta), 1.7W
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta), 1.7W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.3A (Ta), 3.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 3.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	235pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2304DDS-T1-GE3-ND

SI2304DDS-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI2304DDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2304DDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2304DDS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2304DDS-T1 vishai SI2304DDS-T1 vishai</p>	 <p>SI2304DDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 3.3A SOT23</p>	 <p>SI2304CDS-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT23</p>	 <p>SI2304DS,215 NXP Semiconductors / Freescale MOSFET N-CH 30V 1.7A SOT23</p>
 <p>SI2304DS-T1 VISHAY SI2304DS-T1 VISHAY</p>	 <p>SI2304DDS-T1-GE3-S VISHAY VISHAY SOT23</p>	 <p>SI2304DDS-T1-E3 VISHAY SI2304DDS-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>Si2304DDS 89K Si2304DDS 89K</p>

heiße Teile

Mehr

 SI2303BDS-T	 SI2303BDS-T1	 SI2303BDS-T1	 SI2303BDS-T1-E3	 SI2303BDS-T1-E3
 SI2303BDS-T1-GE3	 SI2303BDS-T1-GE3	 SI2303BDS/A5	 SI2303CDS	 SI2303CDS-T1-E3
 SI2303CDS-T1-E3	 SI2303CDS-T1-GE3	 SI2303CDS-T1-GE3	 SI2303DL-T1-E3	 SI2303DS
 SI2303DS-T1	 SI2303DS-T1-E3	 SI2303DS-T1-GE3	 SI2304-TP	 SI2304BDS-T1-E3
 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304BDS-T1-GE3	 SI2304BDS-T1-GE3	 SI2304BDS-TI-E3	 SI2304DDS-T1-E3
 SI2304DDS-T1-GE3	 SI2304DS	 SI2304DS-T1	 SI2304DS-T1-E3	 SI2304DS-T1-GE3
 SI2305-CDS-T1-GE3	 SI2305ADS-T1-E3	 SI2305ADS-T1-E3	 SI2305ADS-T1-GE3	 SI2305ADS-T1-GE3
 SI2305BDS-T1-E3	 SI2305BDS-T1-GE3	 SI2305CDS-T1-E3	 SI2305CDS-T1-GE3	 SI2305CDS-T1-GE3
 SI2305DS	 SI2305DS-E3	 SI2305DS-T1	 SI2305DS-T1-E3	 SI2305DS-T1-E3
 SI2305DS-T1-GE3	 SI2305WCB	 SI2306BDS	 SI2306BDS-T1	 SI2306BDS-T1-E3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

